

2兆位/ 4兆位的SPI串行闪存 SST25VF040



EOL产品数据表

产品特点:

- 单2.7-3.6V读写操作
- 串行接口架构
 - SPI兼容: 模式0和模式3
- 20 MHz的最大时钟频率
- 卓越的可靠性
 - 耐力: 100,000次(典型值)
 - 大于100年数据保存时间
- 低功耗:
 - 读操作工作电流: 7 mA(典型值)
 - 待机电流: 8 μ A(典型值)
- 灵活的擦除能力
 - 统一4K字节扇区
 - 统一32 K字节覆盖块
- 快速擦除和字节编程:
 - 芯片擦除时间: 70毫秒(典型值)
 - 部门或块擦除时间: 18毫秒(典型值)
 - 字节编程时间: 14 μ s(典型值)
- 自动地址递增(AAI)编程
 - 降低整个芯片的编程时间
 - 字节编程操作
- 检测写操作结束的
 - 软件状态
- 保持引脚(HOLD #)
 - 暂停串行序列的记忆
 - 不取消选择器件
- 写保护(WP #)
 - 启用/禁用的锁定功能
 - 状态寄存器
- 软件写保护
 - 通过块保护位的写保护
 - 状态寄存器
- =温度范围
 - 商业: 0 °C至+ 70°C
 - 工业级: -40 °C至+ 85°C
 - 扩展: -20 °C至+ 85°C
- 封装
 - 8引脚SOIC封装200万体积
 - 8触点WSOL (5 \times 6毫米)
- 所有非铅(无铅)器件均符合RoHS标准

产品说明

在SST串行闪存系列具有一个四线, SPI兼容接口, 允许低引脚数封装, 最终降低年龄占用更少的电路板空间, 并最终降低总的系统成本。SST25VF040 SPI串行闪存与SST专有的, 高性能制造曼斯CMOS SuperFlash技术。分裂栅单元设计和厚氧化层隧穿注入器可实现更好的可靠性和可制造性与替代比较的方法。

该SST25VF040设备显著改善性能, 同时降低功耗。总消耗的能量是所施加电压的函数, 电流

租金和应用时间。因为对于任何给定的电压范围, SuperFlash技术, 以更小的电流程序, 并具有擦除时间更短, 总能量在任何擦除消耗或编程操作较少比其他闪存技术。该

SST25VF040器件采用单个2.7-3.6V电源。

该SST25VF040器件采用8引脚SOIC 200密体宽度(S2A)封装和8触点WSOL封装。参见图2的引脚分配。

2兆位/ 4兆位的SPI串行闪存
SST25VF040



EOL产品数据表

引脚说明

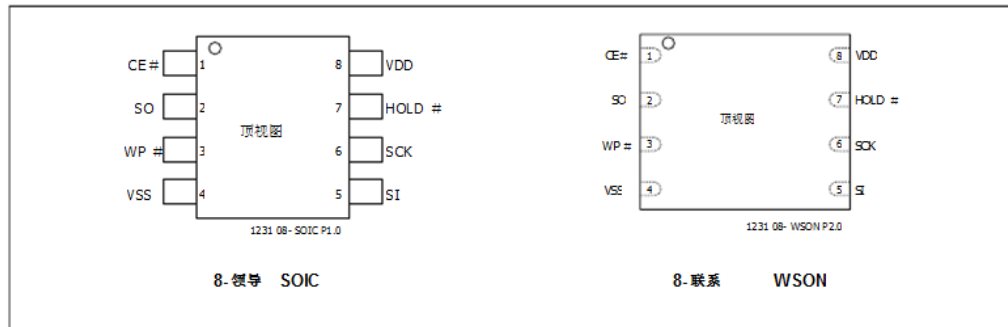


图2：引脚分配

表1：引脚说明

符号	引脚名称	功能
SCK	串行时钟	提供串行接口的定时。命令，地址或输入数据被锁存，在时钟输入的上升沿，而输出数据被移出的时钟输入的下降沿。
SI	串行数据输入	到传送命令，地址或数据串联到器件中。输入被锁定在串行时钟的上升沿。
SO	串行数据输出	以串行方式传输数据出器件。数据被移出在串行时钟的下降沿。
CE#	芯片使能	该装置是由高到CE#低电平的转换功能。CE#必须保持为低电平的持续时间任何命令序列。
WP#	写保护	写保护（WP#）引脚用于启用/禁用状态寄存器的BPL位。
HOLD#	HOLD	要暂时停止与SPI闪存的串行通信，无需重新设置设备。
V _{DD}	电源	提供电源（2.7~3.6V）。
V _{SS}	地	

T1.0 1231(0/4)